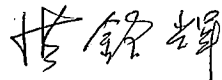


本校案號：02A-101502  
(由產學合作總中心填寫)

## 國立臺灣大學研究成果自行申請專利報備表

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 計畫合作機構                        | 科技部(合作企業:台積電)<br><small>(請填寫本申請案所屬之經費來源,如:國科會、經濟部、農委會等)</small>   | <input type="checkbox"/> 利用本校資源<br><small>(勾選本項則無需填計畫名稱及編號)</small> |
| 計畫名稱及編號                       | 前瞻技術產學合作計畫-7-5mm 半導體技術節點研究(1/5)<br>NSC 102-2622-E-002 -014 -<br><small>(請附計畫經費核定清單或契約書影本)</small>   |   |
| 計畫合作期限及金額                     | 自 102 年 08 月 01 日至 103 年 07 月 31 日<br>新台幣 伍仟玖佰玖拾玖萬伍仟 元整   |   |
| 申請專利名稱                        | Perfecting high k/GaSb interface using molecule beam epitaxy Y2O3   |   |
| 擬申請之國家                        | <input type="checkbox"/> 中華民國 <input checked="" type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br><small>申請日期: 2014/07/18 陳慧蘭 申請號: 14/334,737</small>  |   |
| 自行申請專利理由                      | 依台大-台積電產學合作契約第四條第二項,本成果為台大、台積電共有(6:4);同條第六項規定由合作企業代為提出申請  |   |
| 附件<br><small>(*為必要文件)</small> | <input checked="" type="checkbox"/> *國立臺灣大學研究成果專利發明人資料表(附件一)<br><input checked="" type="checkbox"/> *國立臺灣大學研究成果自行申請之專利申請權讓與合約書(附件二)<br><input type="checkbox"/> 計畫經費核定清單(國科會計畫者)<br><input type="checkbox"/> 研究計畫補助合約書影本(非國科會計畫者) |   |

※請於完成專利申請程序後主動提供專利申請書、說明書、專利申請日及申請號等。

提案人：洪銘輝  (簽章)  
單位：國立臺灣大學/物理系 (台積電中心)  
職稱：教授  
提案日期：103年12月20日

(中心)  
系主任

台積電中心  
主任 李嗣涔

院長

研發長

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 承辦單位：<br>研發處<br>產學合作總中心 |  |
|-------------------------|--|

## 附件一、國立臺灣大學研究成果專利發明人資料表

|      |   |        |  |                |              |
|------|---|--------|--|----------------|--------------|
| 發明人  | ※發明人欄位填寫說明：<br>(1)發明人超過三位時，請自行複製發明人欄位使用。<br>(2)發明人請填寫實際的發明人，參酌美國專利實務上的認定，所謂發明人必須是對發明概念之形成及至少一項申請專利範圍之標的有所貢獻之人，才能稱為發明人。美國專利法規定，若列名之發明人未有發明之事實，則不得取得專利；若發明人記載錯誤，且可證明有「欺瞞之意圖」，則此專利權無法主張權利（單純接受指示，依所設計之實驗完成實驗結果者、提出需求者、提出產品缺點者等無實質貢獻者，不能算是發明人）。<br>(3)未來收益分配之有功人員不限於此專利申請案所列之實際發明人。 |        |  |                |              |
|      | 1   | 姓名     | (中文/英文) 洪銘輝  |                |              |
|      |   | 服務單位   | 國立臺灣大學/物理系   | 職稱             | 教授           |
|      |   | 國籍     | <input checked="" type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____ | 身份證字號<br>或護照字號 | T101530451   |
|      |   | e-mail | mhong@phys.ntu.edu.tw  | 電話             | 02-3366-5193 |
|      |   | 聯絡地址   | 新竹市東區大學路56號19樓之1   |                |              |
|      | 2   | 姓名     | (中文/英文)  |                |              |
|      |   | 服務單位   |  | 職稱             |              |
|      |   | 國籍     | <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____            | 身份證字號<br>或護照字號 |              |
|      |   | e-mail |  | 電話             |              |
|      |   | 聯絡地址   |  |                |              |
|      | 3   | 姓名     | (中文/英文)  |                |              |
|      |   | 服務單位   |  | 職稱             |              |
|      |   | 國籍     | <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____            | 身份證字號<br>或護照字號 |              |
|      |   | e-mail |  | 電話             |              |
| 聯絡地址 |   |        |  |                |              |

## 附件二、國立臺灣大學研究成果自行申請之專利申請權讓與合約書

本校案號：02A-141202  
(由產學合作總中心填寫)

立合約書人：國立臺灣大學（以下簡稱甲方）  
洪銘輝（以下簡稱乙方）

乙方執行 科技部(合作企業:台積電) 補助專題研究計畫「前瞻技術產學合作計畫-7-5mm 半導體技術節點研究(1/5)」(計畫編號: NSC 102-2622-E-002 -014 -) 之研發成果「Perfecting high k/GaSb interface using molecule beam epitaxy Y2O3」, 其智慧財產權屬甲方所有, 惟乙方經甲方同意, 得自行依(美國)專利法申請專利, 約定下列條款, 依誠實信用原則共同遵守:

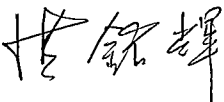
- 一、乙方將研發成果「Perfecting high k/GaSb interface using molecule beam epitaxy Y2O3」先行自費辦理專利申請及維護事宜。乙方自行申請專利時, 其專利申請相關費用、技術移轉(或授權)、權益分配及其他相關事宜, 應由甲方統籌依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理, 乙方應負協助之義務。
- 二、乙方對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務, 未經甲方事前書面同意, 不得逕行終止專利申請或專利維護案, 亦不得逕行將專利申請權或專利權授權他人利用, 或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為。  
乙方不願繼續申請或維護專利權時, 應事情以書面通知甲方, 並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。
- 三、甲方得視需要要求乙方將專利申請權(或專利權)無條件讓與甲方, 並應於接獲甲方通知後, 於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜, 且不得另行要求任何報酬。  
乙方將前項專利申請權(或專利權)讓與完成後, 並經甲方審議通過認為有必要繼續申請或維護者, 得依國立臺灣大學技術移轉業務獎助金與專利及技術移轉個案獎勵金運用分配準則核給乙方發明專利獎勵金。
- 四、乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定, 除應承擔一切法律責任外, 甲方並得視情節輕重要求損害賠償。
- 五、本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止, 但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內, 乙

方應對本合約內容保守秘密，不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。

- 六、本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。
- 七、就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。
- 八、本合約正本一式二份，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺灣大學 (簽章)  
代 表 人：楊泮池  
地 址：臺北市羅斯福路四段一號

乙 方：洪銘輝  (簽章)  
任職單位：教授  
地 址：新竹市東區大學路56號19樓之1

中華民國 103 年 12 月 20 日

## 附件二、國立臺灣大學研究成果自行申請之專利申請權讓與合約書

本校案號：02A-141502  
(由產學合作總中心填寫)

立合約書人：國立臺灣大學（以下簡稱甲方）

洪銘輝（以下簡稱乙方）

乙方執行 科技部(合作企業:台積電) 補助專題研究計畫「前瞻技術產學合作計畫-7-5mm 半導體技術節點研究(1/5)」(計畫編號: NSC 102-2622-E-002 -014 -) 之研發成果「Perfecting high k/GaSb interface using molecule beam epitaxy Y2O3」, 其智慧財產權屬甲方所有, 惟乙方經甲方同意, 得自行依(美國)專利法申請專利, 約定下列條款, 依誠實信用原則共同遵守:

一、乙方將研發成果「Perfecting high k/GaSb interface using molecule beam epitaxy Y2O3」先行自費辦理專利申請及維護事宜。乙方自行申請專利時, 其專利申請相關費用、技術移轉(或授權)、權益分配及其他相關事宜, 應由甲方統籌依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理, 乙方應負協助之義務。

二、乙方對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務, 未經甲方事前書面同意, 不得逕行終止專利申請或專利維護案, 亦不得逕行將專利申請權或專利權授權他人利用, 或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為。

乙方不願繼續申請或維護專利權時, 應事情以書面通知甲方, 並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。

三、甲方得視需要要求乙方將專利申請權(或專利權)無條件讓與甲方, 並應於接獲甲方通知後, 於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜, 且不得另行要求任何報酬。

乙方將前項專利申請權(或專利權)讓與完成後, 並經甲方審議通過認為有必要繼續申請或維護者, 得依國立臺灣大學技術移轉業務獎助金與專利及技術移轉個案獎勵金運用分配準則核給乙方發明專利獎勵金。

四、乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定, 除應承擔一切法律責任外, 甲方並得視情節輕重要求損害賠償。


五、本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止, 但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內, 乙

方應對本合約內容保守秘密，不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。

- 六、本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。
- 七、就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。
- 八、本合約正本一式二份，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺灣大學 (簽章)  
代 表 人：楊泮池  
地 址：臺北市羅斯福路四段一號

✓ 乙 方：洪銘輝  (簽章)  
任職單位：教授  
地 址：新竹市東區大學路56號19樓之1

中華民國 103 年 12 月 20 日